

PA68H

Nチャネル接合形

シリコン複合電界効果トランジスタ

差動増幅用

N-Channel Silicon Dual Junction Field-Effect Transistor
Differential Amplifier

特長/FEATURES

- ステレオ・メイン・アンプ初段の差動増幅用として最適です。

Suitable for the top stage of a stereo main amplifier.

- 電氣的・熱的平衡が優れています。

- 高耐圧です。

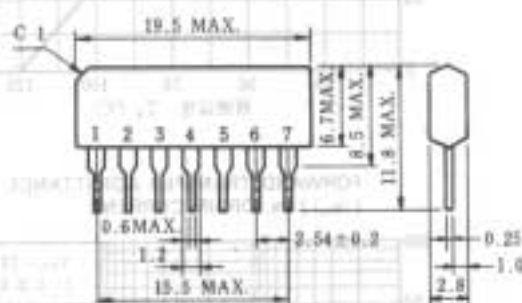
High breakdown voltage.

絶対最大定格/ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ($T_a=25^\circ\text{C}$)

項 目	略 号	定 格	単 位
ゲート・ドレイン間電圧	V_{GD0}	-50	V
ゲート・ソース間電圧	V_{GS0}	-50	V
ドレイン・ソース間電圧	V_{DSX}^*	50	V
ドレイン電流	I_D	30	mA
ゲート電流	I_G	10	mA
全 損 失	P_T	250	mW/unit
ジャンクション温度	T_j	125	$^\circ\text{C}$
保 存 温 度	T_{stg}	-55~+125	$^\circ\text{C}$

* $V_{GS}=-3.0\text{ V}$

外形図/PACKAGE DIMENSIONS (Unit: mm)



端子接続/PIN CONNECTION

端子No	機 能	端子No	機 能
1	1D	5	2S
2	1G	6	2G
3	1S	7	2D
4	Sub		

電氣的特性/ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_a=25^\circ\text{C}$)

項 目	略 号	条 件	MIN.	TYP.	MAX.	単 位
ゲート遮断電流	I_{GSS}	$V_{GS}=-20\text{ V}, V_{DS}=0$			-1.0	nA
ドレイン電流	I_{DSS}	$V_{DS}=10\text{ V}, V_{GS}=0$	1.0		18	mA
ドレイン電流比	I_{DSS} 比	$V_{DS}=10\text{ V}, V_{GS}=0, I_{DSS}$ 比= I_{DSS} 小/ I_{DSS} 大	0.9		1.0	
カットオフ電圧	$V_{GS(off)}$	$V_{DS}=10\text{ V}, I_D=10\text{ }\mu\text{A}$	-0.15		-2.5	V
ゲート・ソース間電圧差	ΔV_{GS}	$V_{DS}=10\text{ V}, I_D=1.0\text{ mA}$		3.0	20	mV
順伝達アドミタンス	$ y_{fs} $	$V_{DS}=10\text{ V}, I_D=1.0\text{ mA}, f=1\text{ kHz}$	5.0	7.0		mS
順伝達アドミタンス比	$ y_{fs} $ 比	$V_{DS}=10\text{ V}, I_D=1.0\text{ mA}, f=1\text{ kHz}, y_{fs} $ 比= $ y_{fs} $ 小/ $ y_{fs} $ 大	0.95		1.0	
入 力 容 量	C_{iss}	$V_{DS}=10\text{ V}, V_{GS}=0, f=1.0\text{ MHz}$		15		pF
帰 還 容 量	C_{rss}	$V_{DS}=10\text{ V}, V_{GS}=0, f=1.0\text{ MHz}$		3.0		pF
雑 音 電 圧	NV	測定回路図参照/See test circuit		25	35	mV

I_{DSS} 区分/ I_{DSS} Classification K: 1.0~6.0 mA L: 5.0~10 mA M: 9.0~14 mA N: 13~18 mA